

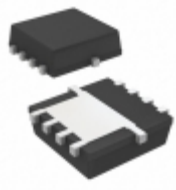


	<h2>SI7794DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7794DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V P-PACK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7794DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3798 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7794DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V P-PACK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3798 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 28.6A (Ta), 60A (Tc) 5W (Ta), 48W
Serie	SkyFET®, TrenchFET® Gen III
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 48W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Body)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28.6A (Ta), 60A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	72nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2.52nF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI7794DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7794DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7794DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7794DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7792DP-T1-GE3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p>SI7802DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 250V 1.24A 1212-8</p>	 <p>SI7802DN-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 250V 1.24A 1212-8</p>	 <p>SI7802DN SI SI7802DN SI</p>
 <p>SI7794DP-T1-GE3 VISHAY VISHAY PAKSO8</p>	 <p>SI7792DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V P-PACK SO-8</p>	 <p>SI7800ADN SI SI7800ADN SI</p>	 <p>SI7798DP-T1-GE3 Vishay Precision Group SI7798DP-T1-GE3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ SI7738DP-T1-E3 ⊖ SI7742DP-T1-GE3 ⊕ SI7758DP-T1-GE3 D SI7784DP-T1-GE3 ⇒ SI7790DP-T1-GE3 ↔ SI7798DP-T1-GE3 ⊕ SI7806ADN-T1-E3 ⊖ SI7806AEDN-T1-E3 ⊕ SI7810DN ↔ SI7812DN-T1-E3 	<ul style="list-style-type: none"> ↔ SI7738DP-T1-GE3 ⊕ SI7748DP-T1-GE3 ⊖ SI7772DP-T1-GE3 ⊕ SI7784DP-T1-GE3 ↔ SI7790DP-T1-GE3 ⇒ SI7804DN D SI7806ADN-T1-E3 ⊕ SI7806BDN ⊖ SI7810DN-T1 ⊕ SI7812DN-T1-E3 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7738DP-T1-GE3 D SI7748DP-T1-GE3 ⊕ SI7772DP-T1-GE3 ⊖ SI7788DP-T1-GE3 ⊕ SI7792DP-T1-GE3 D SI7804DN-T1-E3 ⇒ SI7806ADN-T1-E3-PBF ↔ SI7806BDN-T1-GE3 ⊕ SI7810DN-T1-E ⊖ SI7812DN-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> D SI7742DP-T1-E3 ⇒ SI7758DP ↔ SI7774DP-T1-GE3 ⊕ SI7788DP-T1-GE3 ⊖ SI7792DP-T1-GE3 ⊕ SI7804DN-T1-E3 ↔ SI7806ADN-T1-GE3 ⇒ SI7806DN-T1-E3 D SI7810DN-T1-E3 ⊕ SI7812DN-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7742DP-T1-GE3 ⇒ SI7758DP-T1-GE3 ⇒ SI7774DP-T1-GE3 ⇒ SI7790DP-T1-E3 ⇒ SI7794DP-T1-GE3 ⊖ SI7806ADN ⇒ SI7806ADN-T1-GE3 ⇒ SI7806DN-T1-GE3 ⇒ SI7810DN-T1-E3 ⇒ SI7818DN-T1-E3
--	--	--	--	--

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited